EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

57155789

PUBLICATION DATE

25-09-82

APPLICATION DATE

20-03-81

APPLICATION NUMBER

56041467

APPLICANT: MITSUBISHI ELECTRIC CORP;

INVENTOR: KONDO MITSUSHIGE;

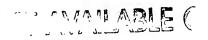
INT.CL.

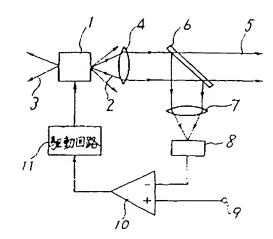
H01S 3/096 H04B 9/00

TITLE

SEMICONDUCTOR LASER

MODULATOR





ABSTRACT :

PURPOSE: To reduce or eliminate nonlinearity and noise of semiconductor laser by providing a differential amplifier to which output of a photosensor is fed back as negative feedback after output of the semiconductor laser is converted to electric output by a photosensor.

CONSTITUTION: A part of output 2 of a semiconductor laser 1 which is driven by a driving circuit 11 is converted to electric signals by the photosensor 8 of good linearity and of less noise through lenses 4, 7 and a beam splitter 6. Output of the photosensor is inputted in a differential amplifier 10, output of which is inputted in the driving circuit 11, i.e. the output from the photosensor 8 functions as negative feedback. This allows reduction or eliminatoin of nonlinearity and noise of the semiconductor laser so that it is possible to use even those elements having a little inferior linearity.

COPYRIGHT: (C)1982, JPO& Japio

DECT ANAMADIE COPY

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭57-155789

(1) Int. Cl.³
H 01 S 3/096
H 04 B 9/00

識別記号

庁内整理番号 7377-5F 6442-5K 砂公開 昭和57年(1982)9月25日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

②改導体レーザ変調装置

2)特

頁 昭56-41467

22出

願 昭56(1981) 3月20日

70発 明 者 伊藤修

尼崎市南清水字中野80番地三菱 電機株式会社応用機器研究所内 ⑫発 明 者 近藤光重

尼崎市南清水字中野80番地三菱 電機株式会社応用機器研究所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2

番3号

⑩代 理 人 弁理士 葛野信一

外1名

明 細 膏

1. 発筋の名称

半事体レーザ変額装置

2. 特許請求の範囲

の入力信号により出射光を強度変調する半速体レーザ変調製量において、上記半導体レーザの出射光の一部を電気信号に変換する光後知器と、この光模知器の出力信号と上記入力信号との差動をとる差動アンプとこの差動アンプの出力信号に応じて上記半導体レーザの駆励配流を制御するレーザ駆励回路とを構え、上記光検知器の出力信号が負滞速となるように構成したことを特徴とする半導体レーザ変調設設。

(3) 半導体レーザの出射光を平行光束にするレンズと、この平行にされた光束中に挿入されたビームスプリッタとを有し、このビームスプリッタで分離された出射光の一部を光候知器で複知するようにしたことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の半導体レーザ変調報数。

は半海体レーザの出射光の中心軸から大きくは

ずれた角度方向成分を光検知器で検知する構成と したことを特徴とする特許高求の範囲第1項記載 の半導体レーザ変調装置。

(4) 半導体レーザの後方出射光の中心軸を含む成分を光検知器で検知する構成としたことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の半導体レーザ変 論装置。

(6) 差動アンブへの入力信号が直流信号であることを特徴とする特許謝求の範囲第1項ないし第4項のいずれかに記載の半巻体レーザ変調装置。

8. 発明の詳細な説明

この発明は半導体レーザ変額装置の変額特性の 改善に関するものである。

半導体レーザは小型で直接変調が可能なレーザ源として、近年、光通信分野で不可欠のものとなっており、また光ディスクメモリ装置の配録再生用光源としても注目されている。第1囟に半導体レーサの光山力 - 鬼流特性を示す。微軸が地流、縦軸が光出力である。図中、領域 A はエレクトロルミネセンス発光領域であり、しまい値を超える

特開昭57-155789(2)

また、半海体レーザはレンズ。ミラーなどからの戻り光があるとノイズの増加する現象があるため、戻り光を少なくするように光学系を設計する必要があつた。

ての発明は上記のような欠点をなくし、直線性の の 題い 素子を使つても変闘 特性の直線性が良好と

(3)

動された前方出射光(2)はレンズ(4)により平行光束 (6)に変換され、光通信又は光ディスク記録などに 利用される。変調された平行光束のは、ビームス プリツタ(6)により一部進行方向を変え、レンズ(7) により染光して光検知器(8)に導かれ、変調光信号 が観気信号に変換され、上述したように差動アン ブのに入力して負帰遺ループを形成するようにな す。ととで、負用週ループの貼ルーフゲインを充 分高くしておけば差動アンプロの入力信号である 入力組子のから入力される変調信号と光検知器の の出力信号とが一致するように半導体レーザ(1)を 駆動するととになる。光検知器に使用する光検知 絮子例えば、小型シリコンフオートダイオードや. シリコンPINフオトダイオードなどは、高速応答 性に優れ、また半導体レーザに比べ、入出力特性 の直線性は良好である。また、検知素子の発生す るノイズは一般に極めて少なく充分な光度を検知 すれば検知系のノイズが問題となることはない。 以上の光検知器の特性から、愛闖された平行光東 (5)の強度変化(光信号波形)と光検知器(8)の出力

なり、また戻り光があつてもノイズの増加しない 半海体レーザ変闘装置を待ることを目的とする。

能2図はこの発明の一実施例を示す図で、(1)は半導体レーサ、(2)は半導体レーザ(1)の触方出射光、(4)は削方出射光、(5)は平行にするためのレンズ、(5)は平行にされた光東、(6)は光東(6)の一部の光を分削して取り出すためのビームスプリッタ、(7)は取り出された光東米するレンズ、(8)は集光された光を検知する光を検知ない。(6)は信号入力端子、如は入力場子のより入力した信号と光検知器(8)により検知された借号の差跡をとる差跡アンプ、のは差跡アンプの出力により、レーザ駆動地流を制御するレーザ駆動回路である。

次に動作について説明する。

入力始子(6) に例えば、PM変調された正弦波信号が入力されるものとする。 この信号と光模知器(8) で検知された信号を正・負入力とする整動アンブロにより、上記 2 信号の差信号を増幅しレーザ駆動回路のを通して半導体レーザ(1)を変調する。変

(4

信号波形は一致している。

以上の説明から光板知器の良好な特性を使ってこのような回路を構成することにより、入力信号波形と変調された平行光(5)の光信号波形は一致なることになる。別ち半導体レーザに非直線性があっても、その非直線性を補正するようにレーザ駆動を流が流れ、戻り光によりノイズ(光出力のゆらぎ)が増加しても、そのノイズを除去するようにレーザ駆動を流が流れるため、程果として変調特性の直線性が良好でノイズのない半導体レーザ変調装量が得られる。

第8図、第4図はそれぞれこの発別の他の実施 例を示す。

前配実施的では、半海体レーザの前方出射光(2)をビームスプリッタ(6)で一部取り出して光検知器へ入射させていたが、第8 箇に示すように半導体レーザの出射光の拡がり円が大きいことを利用して、レンズ(4)の外へもれる光を光検知器(3)へ入射させてもよい。又、銅4 関に示すように後方出射光は前方出射光と同一の特性をもつていることか

特的昭57-155789(3)

5、後方出射光(3)を光検知器(8)へ入射させてもよい。この場合には、被方出射光(3)のほとんどすべての光量を利用できることから開ループゲインを一定に保ては影動アンブののゲインを下げることができ、差動アンブのの設計が容易になり、かつ強信記録再生に使用する前方出射光(3)とは独立しているため、半導体レーザ(1)、光検知器(8)、差動アンブの及びレーザ駆動回転のをすべてワンパッケーツに収納することが容易になる。

また、上記説明では変調信号としてFM変調正弦 被信号を考えてきたが、それ以外の変調信号(例 えばパルス変調信号)であつてもよく、また 負流 信号であつてもよい。この場合、平行光束(のは温 後ドリフトを含めてノイズのない 直流光になり、 たとえばビデオディスク、 PCMオーディオディスク の第の光学式情報再生装値及び光計測などの光歌 としても利用できることは言うまでもない。

第 5 図にこの発明に係る半導体レーザ変調装置を光ディスクメモリ記録再生装置に適用した例を示す。記録時、入力信号により強度変調された平

(7)

性及びノイズが軽減・除去され信号品質が向上すると同時に、従来、直線性の良い半導体レーザを 超別していたものを多少直線性の悪い業子をも使 用可能となり、戻り光があつてもノイズが増加し ないことから光学系の設計が容易になる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は半導体レーザの光出力 - 電流特性図、 第2図はとの発明の一実施例のブロック図、第8 図及び第4図はそれぞれこの発明の他の実施例の ブロック図である。

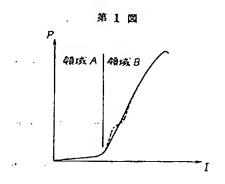
図において、(1) は半導体レーザ、(2) は前方出射 光、(3) は後方出射光、(4) 、(7) 、04 、09 はレンズ、 (6) 、切はビームスプリツタ、(8) 、03 は光板知器、 09 は差動アンプ、似はレーザ駆削回路、49 は 1/4 板、94 はディスクである。

代理人 萬野佰一(外1名)

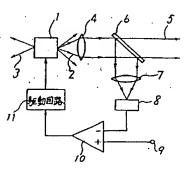
行光東(5)は、ビームスプリッタの、 A/4 板の、レンズのにより回転するディスクのの数面上に小スポットに無光され、光エネルギーでディスクのの表面上に情報を記録していく。

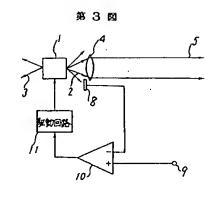
以上のようにこの発明によれば、直線性がよく ノイズの少ない光模知器で半導体レーザの出射光 の一部を検知し、その検知した信号と入力信号の 差個号で半導体レーザを駆動し、帰避を負帰避と なるように橡成したので、半導体レーザの非道線

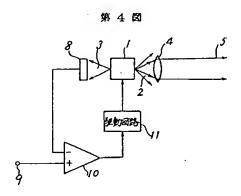
(8)

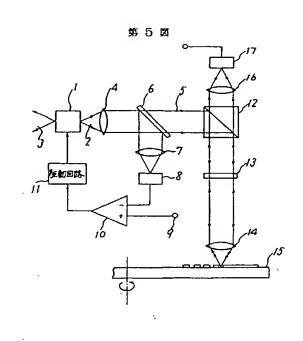


第2図









続 補 正 巻(方式) 昭和 56年 7月13日

適

特許庁長官殿

特願昭 58 - 41467 号 1. 事件の表示

半導体レーザ変調装置。 2. 発明の名称

6. 補正命令の日付 昭和56年6月80日

6. 補正の対象

明細書の図面の簡単な説明の欄

補正の内容

明細啓第9頁第11行に「ブロック図である。」 とあるのを「ブロック図、第5図はこの発明を光 ディスクメモリ記録再生装置に適用した実施例を 示すプロック図である」と訂正する。

> EL Ŀ

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

称 (601) **三 死** 花 機 株 式 会 社

山仁八郎 4. 代 理

人 住 所

氏 名(6699)